

装置番号	施設名称	試料寸法	設置場所	装置分類	共用施設等 使用料	技術指導 等費
					(円/時間)	(円/時間)
MEMS001	ウェハディップ洗浄装置	200 mm/300 mm	TKB812-F	処理	6,000	7,500
MEMS002	ウェハスピン洗浄装置	200 mm/300 mm	TKB812-F	処理	6,000	7,500
MEMS003	有機ドラフト	300 mm以下	TKB812-F	処理	6,000	7,500
MEMS004	異方性ウェットエッチング装置	200 mm	TKB812-F	加工	12,000	7,500
MEMS005	IPAペーパー乾燥機	200 mm	TKB812-F	処理	6,000	7,500
MEMS006	i-線ステツパ	200 mm	TKB812-F	加工	18,000	7,500
MEMS007	マスク露光装置	150 mm/200 mm	TKB812-F	加工	12,000	7,500
MEMS008	マスクレス露光装置	500 mm角以下	TKB812-F	加工	12,000	7,500
MEMS010	光学顕微鏡(注1)	300 mm以下	TKB812-F	分析・評価	6,000	7,500
MEMS011	Si酸化膜プラズマCVD装置	200 mm/300 mm	TKB812-F	加工	14,000	7,500
MEMS012	スパッタ	200 mm	TKB812-B	加工	12,000	7,500
MEMS013	酸化炉	200 mm	TKB812-F	加工	12,000	7,500
MEMS014	アニール炉	200 mm	TKB812-F	加工	12,000	7,500
MEMS015	Si窒化膜減圧CVD装置	200 mm	TKB812-F	加工	12,000	7,500
MEMS016	ポリSi減圧CVD装置	200 mm	TKB812-F	加工	12,000	7,500
MEMS017	金属膜ドライエッチング装置	200 mm	TKB812-F	加工	12,000	7,500
MEMS018	Si酸化膜ドライエッチング装置	200 mm	TKB812-F	加工	12,000	7,500
MEMS019	8"Si深掘ドライエッチング装置	200 mm	TKB812-F	加工	14,000	7,500
MEMS020	12"Si深掘ドライエッチング装置	300 mm	TKB812-F	加工	18,000	7,500
MEMS021	犠牲層ドライエッチング装置	100 mm/150 mm/200 mm	TKB812-F	加工	12,000	7,500
MEMS022	アッシャー	200 mm/300 mm	TKB812-F	加工	6,000	7,500
MEMS023	光学検査顕微鏡(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	12,000	7,500
MEMS024	段差測定器(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	12,000	7,500
MEMS025	エリブソメーター(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	12,000	7,500
MEMS026	膜厚測定器(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	12,000	7,500
MEMS027	ウェハ塵埃検査装置(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	12,000	7,500
MEMS028	干渉型表面形状評価装置(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	12,000	7,500
MEMS029	シート抵抗プローバー(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	12,000	7,500
MEMS030	赤外線レーザ顕微鏡(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	12,000	7,500
MEMS031	レーザ顕微鏡(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	12,000	7,500
MEMS032	ブレードダイサー	300 mm以下	2A-CR	加工	12,000	7,500
MEMS033	レーザステルスダイサー	200 mm以下	2A-CR	加工	14,000	7,500
MEMS034	光学顕微鏡(注1)	300 mm以下	2A-CR	分析・評価	6,000	7,500
MEMS035	大面積ナノインプリント装置	200 mm角以下	2A-CR	加工	12,000	7,500
MEMS036	電子ビーム/抵抗蒸着装置	200 mm/300 mm	TKB812-B	加工	12,000	7,500
MEMS037	熱処理装置	200 mm	TKB812-B	加工	12,000	7,500
MEMS038	チップtoウェハ接合装置	100 mm/150 mm/200 mm/300 mm	TKB812-B	加工	14,000	7,500
MEMS039	ウェハtoウェハ接合装置	100 mm/150 mm/200 mm	TKB812-B	加工	14,000	7,500
MEMS040	パリレンコーター	100 mm	2G実験室	加工	12,000	7,500
MEMS041	光表面処理装置	200 mm	TKB812-B	処理	12,000	7,500
MEMS042	12"ウェハ常温接合装置	100 mm/150 mm/200 mm/300 mm	TKB812-B	加工	14,000	7,500
MEMS043	測長SEM	200 mm	TKB812-B	分析・評価	12,000	7,500
MEMS044	分析SEM	100 mm/150 mm/200 mm/300 mm	TKB812-B	分析・評価	6,000	7,500
MEMS045	超音波顕微鏡(注2)	300 mm以下	TKB812-B	分析・評価	12,000	7,500
MEMS046	赤外線顕微鏡(注2)	200 mm以下	TKB812-B	分析・評価	12,000	7,500
MEMS047	薄膜応力評価装置(注2)	200 mm	TKB812-B	分析・評価	12,000	7,500
MEMS048	X線CT評価装置	200 mm/300 mm	TKB812-B	分析・評価	14,000	7,500
MEMS049	テスタープローバー	200 mm以下	TKB812-B	分析・評価	12,000	7,500
MEMS050	光学顕微鏡(注1)	300 mm以下	TKB812-B	分析・評価	6,000	7,500
MEMS053	ダイシエアテスタ	100 mm以下	TKB812-B	分析・評価	12,000	7,500
MEMS054	大面積コーターディベロツパ	500 mm角以下	TKB812-F	加工	6,000	7,500
MEMS055	レジストスプレーコータ	200 mm 角以下	2G-CR	加工	6,000	7,500
MEMS056	反応性イオンエッチング装置	200 mm	2G-CR	加工	12,000	7,500
MEMS057	全反射蛍光X線装置	200 mm/ 300 mm	TKB812-F	分析・評価	14,000	7,500
MEMS058	無機ドラフト	300mm以下	TKB812-F	処理	6,000	7,500
MEMS059	レジスト塗布現像装置	200 mm	TKB812-F	分析・評価	12,000	7,500

装置番号	施設名称	試料寸法	設置場所	装置分類	共用施設等 使用料	技術指導 等費
					(円/時間)	(円/時間)
MEMS060	イオンミリング装置	200mm以下	TKB812-B	加工	12,000	7,500
MEMS061	電界放射形SEM	100 mm以下	2A実験室	分析・評価	12,000	7,500
MEMS062	4"Si深掘りドライエッチング装置(注3)	100 mm以下	2G-CR	加工	12,000	7,500
MEMS063	4"スパッタ装置	100 mm以下	2G-CR	加工	10,000	7,500
MEMS064	化学ドラフト	100 mm以下	2G-CR	処理	6,000	7,500
MEMS065	4"酸化炉(注3)	100 mm以下	2G-CR	加工	3,000	7,500
MEMS066	4"フォトリソグラフィー設備	100 mm以下	2G-CR	加工	6,000	7,500
MEMS067	レーザ描画装置	100 mm以下	2G-CR	加工	12,000	7,500
MEMS068	小型ナノインプリント装置	20 mm以下	2G-CR	加工	10,000	7,500
MEMS069	自動光学顕微鏡	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	6,000	7,500
MEMS070	レーザドップラー測定器	200mm以下	TKB812-B	分析・評価	12,000	7,500
MEMS071	フーリエ変換赤外分光装置	200 mm以下	TKB812-B	分析・評価	12,000	7,500

装置番号: MEMS研究開発拠点で装置管理のために使用している番号

設置場所: 装置が設置してある部屋

装置分類: 装置の利用目的や原理に応じて分類された区分

(注1)「MEMS010」「MEMS034」「MEMS050」以外の装置との併用の場合は無料

(注2) 12000円/時の装置との併用の場合は無料

(注3) オペレーターによる技術代行のみ(共用施設利用料+技術指導等費)

※この単価表に記載した金額に消費税及び運営管理費等は含まれておりません。消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てで処理致し